

高圧高速整流

SILICON HIGH VOLTAGE RECTIFYING DIODES

MD-8N(H)10

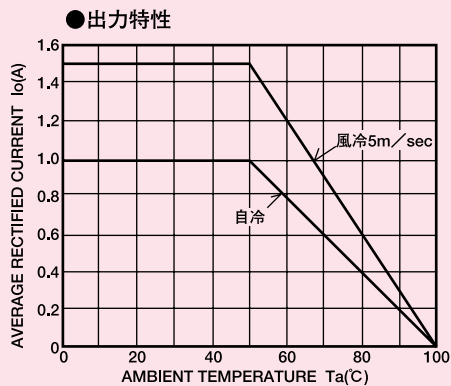
●8kV ●1A連続(自冷)

- 特長
 1. バックパワーが大きくアバランシェ特性を有しています。
 2. 順サージ電流が非常に大きい(70A)。
- 用途
 1. 低周波(Nタイプ)、高周波(Hタイプ)の整流用。
 2. CO₂レーザー等の高電圧、大電流電源用。

- FEATURES
 1. Excellent avalanche breakdown characteristics.
 2. Large surge forward current(70A).
- APPLICATIONS
 1. High frequency(H type)
Low frequency(N type)
 2. CO₂ laser

●定格 (Ta=25°C)
Characteristics (Ta=25°C, unless otherwise specified)

項目 Items	記号 Symbols	単位 Unit	条件 Conditions	形名 Type		
				MD-8N10	MD-8H10	
絶対最大定格 Absolute maximum ratings	せん頭逆電圧	V _{RM}	kV	8		
	平均整流電流	I _o	A	1 <small>Ta=50°C、50Hz正弦半波、抵抗負荷、気中</small>		
	せん頭順サージ電流	I _{FSM}	A	70 <small>Tj=25°C、50Hz正弦半波、波高値、非繰返し</small>		
	接合部温度	T _j	°C	-30~+100	-30~+100	
	保存温度	T _{stg}	°C	-30~+100	-30~+100	
電気的特性 Electrical characteristics	順電圧	V _F	V	I _F =1A	MAX 8	MAX 9.5
	逆電流	I _R	μA	V _R =8kV	MAX 50	MAX 10
	逆回復時間	trr	μs	Ta=25°C I _F =I _R =1A	—	MAX 0.7
用途				低周波用	高周波用	



●外形図 Outline (単位: mm)
重量: 105g

